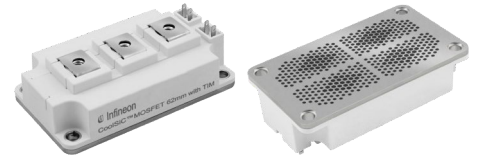


62mm 2 kV CoolSiC™ MOSFET M1H

インフィニオンの62 mm CoolSiC™ MOSFETハーフブリッジモジュールに2 kV品が加わりました。2.6 mΩおよび3.5 mΩの製品があり、M1H技術による $V_{GS(th)}$ ドリフトおよび $R_{DS(on)}$ ドリフト、負のゲート駆動電圧ウィンドウに関するチップ性能を向上させています。また、両製品とも熱伝導材料 (TIM) 塗布オプションを選択することができます。



主な特長

- > ゲート酸化膜の高い信頼性
- > 高い耐湿性
- > 堅牢なボディダイオードを内蔵し、最適な温度条件を実現堅牢なボディダイオードを内蔵し、最適な温度条件を実現
- > 宇宙線に対する高い堅牢性

主な利点

- > 厳しい条件下での使用に最適化
- > 電圧オーバーシュートの低減
- > 導通損失の最小化
- > 高速スイッチングできわめて低い損失
- > 上段と下段のスイッチが同じ動作をするような対称的なモジュール設計
- > 標準的なモジュール構造技術により、高い信頼性を確保
- > 62mmの量産ラインで生産

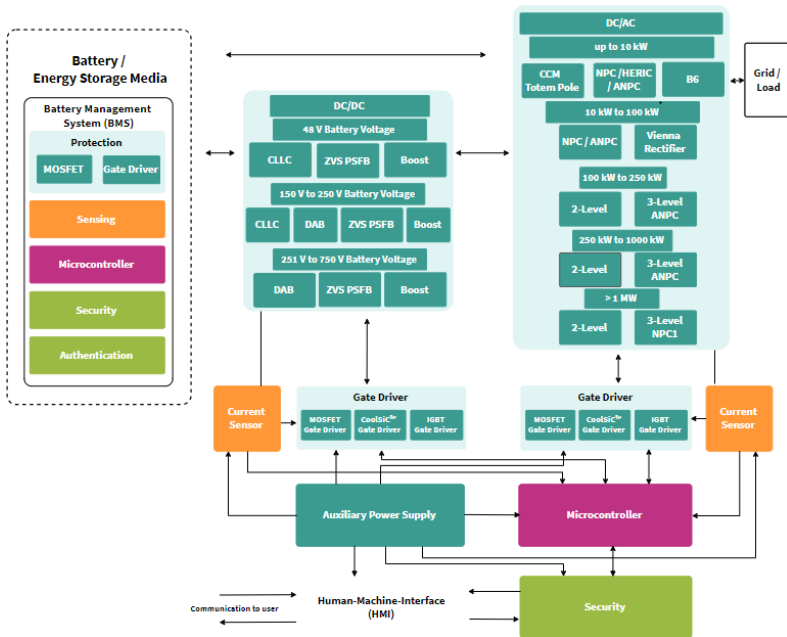
対象アプリケーション

- > 蓄電システム
- > EV充電
- > 太陽光発電
- > トラクション
- > 無停電電源装置 (UPS)

競合製品に対する優位性

- > SiCによる成熟した62mmパッケージ技術の拡張により、高速スイッチングと低損失ともに要求されるアプリケーションに対応。
- > 高い電流密度と耐湿性

ブロック図



製品関連情報/オンライン サポート

製品ファミリーページ

製品ページ: FF3MR20KM1H

製品ページ: FF3MR20KM1HP

製品ページ: FF4MR20KM1H

製品ページ: FF4MR20KM1HP

製品概要およびデータシートリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
FF3MR20KM1HHPA1	SP005593423	AG-62MMHB-3111
FF3MR20KM1HPHPA1	SP005727403	AG-62MMHB-3111
FF4MR20KM1HHPA1	SP005349686	AG-62MMHB-3111
FF4MR20KM1HPHPA1	SP005727413	AG-62MMHB-3111

【62mm 2 kV CoolSiC™ MOSFET M1H】

FAQ

- Why Infineon offers new CoolSiC™ technology in 62mm housing?
 - > 62mm modules are widely used in different application and system designs
- What are the main system requirements to use new CoolSiC™ technology?
 - > Low inductive DC link construction to minimize overvoltage and oscillations
- Are the modules available with TIM?
 - > All modules are available with or without TIM